

	<h2 style="color: red;">SI4914DY-T1-E3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4914DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4914DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 63921 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4914DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	63921 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	1.1W, 1.16W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4914DY-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Half Bridge) 30V 5.5A, 5.7A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A, 5.7A
Basisteilenummer	SI4914

SI4914DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4914DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4914DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4914DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4914DY-T1-E3. VISHAY SI4914DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4914BDY-TI-E3 VISHAY SI4914BDY-TI-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4916DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>	 <p>SI4916DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>
 <p>SI4914BDY-TI-GE3 SOP8 VISHAY SI4914BDY-TI-GE3 SOP8 VISHAY</p>	 <p>SI4916DY SI SI4916DY SI</p>	 <p>SI4914BDYT-T1-E3 VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4916DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>

SI4914DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4914DY-T1-E3 Datenblatt	SI4914DY-T1-E3-Datenblätter	SI4914DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4914DY-T1-E3
SI4914DY-T1-E3 Electronic	SI4914DY-T1-E3-Komponenten	SI4914DY-T1-E3-Verteiler	SI4914DY-T1-E3-Bild	SI4914DY-T1-E3-Teil
SI4914DY-T1-E3 Preis	SI4914DY-T1-E3 Hersteller	SI4914DY-T1-E3 Bild	SI4914DY-T1-E3 Aktie	SI4914DY-T1-E3 Inventar
SI4914DY-T1-E3 Neu	SI4914DY-T1-E3 Original	SI4914DY-T1-E3 garantiert	SI4914DY-T1-E3 RFQ	SI4914DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited